

Kundenspezifische Ptfе-Wafer-Reinigungs Körbe Halter Für Halbleiter-Siliziumwafer Niedrig Hintergrund Fluorpolymer-Kassetten

Artikelnummer: PL-CP266



Einführung

Hochreine kundenspezifische PTFE-Wafer-Reinigungs Körbe für die Halbleiterverarbeitung. Entwickelt für Spurenanalysen mit niedrigem Hintergrund und aggressive Chemikalienbeständigkeit gewährleisten diese maßgefertigten Fluorpolymer-Kassetten null Auflösung und kontaminationsfreie Handhabung von Siliziumwafern in kritischen Reinraumumgebungen und industriellen Laboratorien.

[Mehr erfahren](#)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
RCA-Reinigung (SC-1/SC-2)	Entfernung von organischen Verunreinigungen, dünnen Oxidschichten und ionischen Verunreinigungen von Siliziumoberflächen.	Hohe Beständigkeit gegen Wasserstoffperoxid- und Ammoniumhydroxid-Gemische.
Fluorwasserstoffätzung	Selektive Entfernung von Siliziumdioxidschichten und Oberflächenpassivierung.	Vollständige Beständigkeit gegen HF, das ansonsten Quarz- oder Glas-Träger zersetzt.
Piranha-Ätzverarbeitung	Aggressive Entfernung von schweren organischen Rückständen und Fotoresist unter Verwendung von Schwefelsäure und Peroxid.	Behält die strukturelle Integrität in stark exothermen und oxidierenden Umgebungen bei.
Photolithographie-Unterstützung	Handhabung von Wafern während der Entwicklung, Entfernung und Spülung von Fotoresistmaterialien.	Lösungsmittelbeständigkeit stellt sicher, dass der Träger bei Kontakt mit Entfernern nicht aufquillt oder erweicht.
Spülung nach CMP	Kritische Reinigung von Wafern nach der chemisch-mechanischen Planarisierung zur Entfernung von abrasiven Schleifpasten.	Oberfläche mit geringer Partikelbildung stellt sicher, dass Wafer nach dem Polierschritt sauber bleiben.
Vorbereitung von Verbindungshalbleitern	Spezialisierte Reinigung von GaAs-, GaN- und InP-Wafern für fortschrittliche Optoelektronik.	Schonende, präzise geschlitzte Unterstützung verhindert Beschädigungen von spröden Verbindungsmaterialien.
Ultraschall-/Megasonic-Reinigung	Die Materialeigenschaften dämpfen übermäßige Vibrationen und ermöglichen gleichzeitig eine effektive Energieübertragung.	
Parameterkategorie	Spezifikationsdetail für PL-CP266	
Hauptmaterial	Hochreines PTFE (Polytetrafluorethylen) / PFA (Perfluoralkoxy)	
Herstellungsverfahren	Hochpräzise CNC-Bearbeitung (Kundenspezifisch gefertigt)	
Kompatibilität mit Wafergrößen	Vollständig anpassbar (Häufige Größen: 2", 3", 4", 6", 8", 12" oder kundenspezifische Abmessungen)	
Schlitzkonfiguration	Kundenspezifischer Abstand, Tiefe und Menge nach Prozessanforderungen	
Griffdesign	Fest, abnehmbar oder integrierte Hebeösen verfügbar (Anpassbar)	
Chemikalienbeständigkeit	Ausgezeichnet (Kompatibel mit allen Säuren, Basen und organischen Lösungsmitteln)	

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Parameterkategorie	Spezifikationsdetail für PL-CP266	
Betriebstemperaturbereich	-200°C bis +260°C (Materialgrenze; anwendungsabhängig)	
Oberflächenrauigkeit	Kontrollierte CNC-Oberfläche für minimale Partikeleinschluss	
Spurenelement-Hintergrund	Optimiert für Spurenanalysen mit niedrigem Hintergrund (<input type="checkbox"/>)	
Auflösungsprofil	Keine Auflösung / Keine auslaugbaren Zusatzstoffe (<input type="checkbox"/>)	